

Содержание

• Симпозиум „Нанофизика и Нанoeлектроника“,
Нижний Новгород, март 2013 г.

Андреанов А.В., Алексеев П.С., Клишко Г.В., Иванов С.В., Щеглов В.Л., Седова М.А., Захарьин А.О.
Генерация когерентного терагерцового излучения поляризованными электронно-дырочными парами в квантовых ямах GaAs/AlGaAs 1441

Румянцев В.В., Иконников А.В., Антонов А.В., Морозов С.В., Жолудев М.С., Спиринов К.Е., Гавриленко В.И., Дворецкий С.А., Михайлов Н.Н.
Особенности спектров и кинетики релаксации длинноволновой фотопроводимости в узкозонных эпитаксиальных пленках и гетероструктурах с квантовыми ямами на основе HgCdTe 1446

Кукушкин В.А.
Моделирование генерации импульсов ультрафиолетового и мягкого рентгеновского излучения в результате кооперативной рекомбинации экситонов в нанокристаллах алмаза, внедренных в полимерную пленку 1451

Арапов Ю.Г., Гудина С.В., Клепикова А.С., Неверов В.Н., Подгорных С.М., Якунин М.В., Звонков Б.Н.
Эффекты туннелирования в наклонных магнитных полях в структурах n -InGaAs/GaAs с двойными сильно-связанными квантовыми ямами 1457

Тонких А.А., Талалаев В.Г., Werner P.
Псевдоморфные гетероструктуры GeSn/Ge(001) 1462

Суханов А.А., Сабликов В.А.
Спин-поляризованные токи в туннельном контакте нормального проводника и двумерного топологического изолятора 1467

Морозов С.В., Румянцев В.В., Кудрявцев К.Е., Гавриленко В.И., Козлов Д.В.
Кинетика релаксации примесной фотопроводимости в p -Si:B с различным уровнем легирования и степенью компенсации в сильных электрических полях 1472

Сабликов В.А.
Метастабильные состояния — возможный механизм аномалий контактного мезоскопического структур 1476

Мурель А.В., Данильцев В.М., Демидов Е.В., Дроздов М.Н., Шашкин В.И.
Влияние быстрого термического отжига на параметры арсенидгаллиевого низкобарьерного диода с приповерхностным δ -легированием 1481

Алешкин В.Я., Афоненко А.А., Дикарёва Н.В., Дубинов А.А., Кудрявцев К.Е., Морозов С.В., Некоркин С.М.
Волноводный эффект квантовых ям GaAsSb в лазерной структуре на основе GaAs 1486

Каган М.С., Алтухов И.В., Баранов А.Н., Ильинская Н.Д., Папроцкий С.К., Тесье Р., Усикова А.А.
Проявление эффекта Пёрселла в проводимости короткопериодных сверхрешеток InAs/AlSb 1489

Дроздов М.Н., Новиков А.В., Юрасов Д.В.
Сегрегация сурьмы в напряженных SiGe-гетероструктурах, выращенных методом молекулярно-пучковой эпитаксии 1493

Калинин К.П., Криштопенко С.С., Маремьянин К.В., Спиринов К.Е., Гавриленко В.И., Бирюков А.А., Байдусь Н.В., Звонков Б.Н.
Спиновое расщепление Рашбы и циклотронный резонанс в напряженных гетероструктурах InGaAs/InP с двумерным электронным газом 1497

Кочерешко В.П., Платонов А.В., Саввидис П., Кавокин А.В., Блез Ж., Мариетт А.
Конденсация экситонов в микрорезонаторах в условиях трехмерного квантования 1504

Яблонский А.Н., Байдакова Н.А., Новиков А.В., Лобанов Д.Н.
Кинетика фотолюминесценции самоформирующихся Ge(Si) островков в многослойных структурах SiGe/Si и SiGe/SOI 1509

Антонов А.В., Кудрявцев К.Е., Шенгуров Д.В., Шмагин В.Б., Красильник З.Ф.
Особенности примесной фотопроводимости в эпитаксиальных диодах Si:Er/Si 1513

Морозов С.В., Крыжков Д.И., Алешкин В.Я., Звонков Б.Н., Вихрова О.И.
Спектрокинетические свойства гетероструктур с квантовыми ямами на основе GaAsSb/InGaAs/GaAs, излучающих в области 1.0–1.2 мкм 1517

Конаков А.А., Курова Н.В., Бурдов В.А.
Влияние спин-орбитального взаимодействия на структуру основного состояния электронов в кремниевых нанокристаллах 1521

Винниченко М.Я., Воробьев Л.Е., Фирсов Д.А., Машко М.О., Балагула Р.М., Belenky G., Shteren-gas L., Kipshidze G.
Зависимость концентрации носителей заряда от тока в инжекционных лазерах среднего инфракрасного диапазона с квантовыми ямами 1526

• Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления

Баграев Н.Т., Клячкин Л.Е., Кузьмин Р.В., Маляренко А.М., Машков В.А.
Особенности формирования спектров электролюминесценции квантово-размерных кремниевых p^+ - n -гетеропереходов в инфракрасном диапазоне длин волн 1530

Пархоменко Я.А., Иванов Э.В., Моисеев К.Д.

Особенности электролюминесценции в гетероструктурах с квантовыми точками InSb в матрице InAs 1536

**Щукин В.А., Леденцов Н.Н., Карачинский Л.Я.,
Блохин С.А., Новиков И.И., Богословский Н.А.,
Савельев А.В.**

Высокоэффективная электрооптическая полупроводниковая среда на основе гетероструктур второго рода 1542

**Лебедев А.А., Заморянская М.В., Давыдов С.Ю.,
Кириленко Д.А., Лебедев С.П., Сорокин Л.М., Шу-
стов Д.Б., Щеглов М.П.**

Исследование переходного слоя в гетероструктурах 3C-SiC/6H-SiC 1554

● **Персоналии**

Бахрам Мехралы оглы Аскеров 1559